

Изобретение относится к области материаловедения и может быть использовано в радиоэлектронном, полупроводниковом и оптоэлектронном приборостроении, а именно, при производстве приборов инфракрасного диапазона. Способ снижения концентрации акцепторов в собственно-дефектных кристаллах, в соответствии с которым кристаллы выращивают вертикальным способом Бриджмена или способом твердотельной рекристаллизации, причем из выращенного кристалла вырезают среднюю часть, полученные слитки разрезают на образцы в форме параллелепипедов с размерами  $(2 \times 2 \times 6)$  мм, механически шлифуют и химически полируют в бромметанольном травителе 5 %  $\text{Br}_2$  + 95 %  $\text{CH}_3\text{OH}$ , и деформируют динамической нагрузкой вдоль длинного ребра при комнатной температуре до относительной деформации  $\varepsilon \leq 2\%$ , после чего химически травливают деформированный слой, обогащенный дислокациями, на толщину 100-200 мкм. Техническим результатом изобретения является уменьшение концентрации акцепторов в собственно-дефектных кристаллах.